

ПОЛЯРИТОНЫ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СВЕРХРЕШЕТКЕ

Э.Р. ГУСЕЙНОВ, Р.Р. ГУСЕЙНОВ

Институт Физики АН Азербайджана

370143, Баку, пр. Г. Джавида, 33

(Поступило 15.04.96)

Рассмотрена возможность распространения в полупроводниковой сверхрешетке электромагнитных волн-поляритонов с частотами, близкими к экситонным. Найдены решения уравнений Максвелла с учетом электромагнитного отклика среды, и получен спектр ТЕ и ТМ-поляритонов.

В работе [1] на основе результатов [2] было показано, что в полупроводниковых пленках, толщина которых меньше эффективного радиуса основного состояния экситонов, а диэлектрическая проницаемость много больше диэлектрической проницаемости окружающей пленку среды, силы осцилляторов экситонов резко возрастают с уменьшением толщины пленки. В окрестности экситонных линий при этом увеличивается отражательная способность пленки, и создаются условия для распространения локализованных вблизи пленки электромагнитных волн-поляритонов.

С другой стороны, в работах [3-4] рассмотрены экситонные состояния в специальном образом устроенной полупроводниковой сверхрешетке, состоящей из чередующихся слоев малой толщины d с большой диэлектрической проницаемостью ϵ , и большой толщины a с малой диэлектрической проницаемостью ϵ_1 . Было показано, что экситонные состояния в тонких слоях аналогичны рассмотренным в [2], и зависимость энергии и радиуса основного состояния от толщины слоя в основном такая же, как в [2].

Такая аналогия позволяет рассмотреть возможность распространения в сверхрешетке ($d \ll a$, $\epsilon \gg \epsilon_1$) электромагнитных волн-поляритонов с частотами, близкими к экситонным.

Следуя работе [1], запишем вклад экситонного перехода в слоях типа d в электромагнитный отклик сверхрешетки на поле с частотой ω и проекцией на плоскость слоя волнового вектора \vec{k} в виде плотности навесного тока:

$$j_a(\vec{k}, \omega; z) = -i\omega\Lambda_{\alpha\beta} \chi_{i\alpha} \bar{E}_\beta 2\sin^2 \frac{\pi z}{d}, \quad (1)$$

$$\chi_{i\alpha} = \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{e^2}{\epsilon_1 d} \right)^2 \pi |V_{cv}|^2 \frac{2\mathcal{E}_k}{\mathcal{E}_k^2 - (\hbar\omega)^2}, \quad (2)$$

$$\bar{E} = \frac{2}{d} \int_0^d \bar{E}(\vec{k}, \omega; z) \sin^2 \frac{\pi z}{d} dz. \quad (3)$$

Здесь \bar{E} - электрическое поле, z - координата нормальная к плоскости слоев, начало координат расположено на границе слоев типа d (слева) и a (справа) в "нулевой ячейке" сверхрешетки, \mathcal{E}_k - энергия экситона, V_{cv} - матричный элемент оператора скорости для

перехода из валентной зоны в зону проводимости, функции $\sqrt{\frac{2}{d}} \sin \frac{\pi z}{d}$ описывают размерно квантованное поперечное движение электронов и дырок в слоях типа d . Безразмерные коэффициенты $\Lambda_{\alpha\beta} \sim 1$ характеризуют поляризационные свойства экситонного перехода и зависят от симметрии c и v -зон. Для простоты будем считать материалы слоев сверхрешетки оптически изотропными. Тогда $\Lambda_{\alpha\beta}$ - диагональная матрица, причем

$$\Lambda_{xx} = \Lambda_{yy} = \Lambda_{\perp\perp} \text{ и } \Lambda_{zz} = \Lambda_{\parallel}$$

Мы ищем волны вида:

$$\bar{E}(\vec{\rho}, t; z) = \bar{E}(\vec{k}, \omega; z) e^{i(\vec{k}\vec{\rho} - \omega t)}$$

и аналогично - для магнитного поля, причем $\vec{\rho}$ - двумерный вектор в плоскости слоев. Тогда уравнения Максвелла могут быть записаны для амплитуд полей $\bar{E}(\vec{k}, \omega; z)$ и $\bar{H}(\vec{k}, \omega; z)$, которые далее мы будем писать просто как \bar{E} и \bar{H} .

Рассмотрим две независимые поляризации - поперечно-электрическую (ТЕ) и поперечно-магнитную (ТМ).

1. Поперечно-электрические (ТЕ) поляритоны.

В этой поляризации \bar{E} направлено по оси x , т.е. $\bar{E}(E_x, 0, 0)$, а \bar{H} имеет две отличные от нуля компоненты, т.е. $\bar{H}(0, H_y, H_z)$. Не ограничивая общности, можно направить ось y по \vec{k} и, таким образом, двумерный вектор \vec{k} имеет только одну отличную от нуля компоненту $\vec{k}(0, k)$.

Система уравнений Максвелла в слоях типа d имеет следующий вид:

$$\frac{dE_x}{dz} = \frac{i\omega}{c} H_y \quad (4)$$

$$kE_x = -\frac{\omega}{c} H_z \quad (5)$$

$$ikH_z - \frac{dH_y}{dz} = -\frac{i\omega}{c} \epsilon E_x + \frac{4\pi}{c} j_x \quad (6)$$

В слоях типа *a* в уравнении (6) не будет плотности тока j_x и вместо ε будет ε_1 . Из уравнений (4)-(6) легко получается уравнение второго порядка для одной неизвестной функции E_x :

$$\frac{d^2 E_x}{dz^2} + \varepsilon^2 E_x = -i \frac{4\pi\omega}{c^2} j_x \quad -d < z < 0 \quad (7)$$

$$\frac{d^2 E_x}{dz^2} + \varepsilon_1^2 E_x = 0 \quad 0 < z < a \quad (8)$$

$$\text{где } \varepsilon^2 = \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} - k^2, \quad \varepsilon_1^2 = \varepsilon_1 \frac{\omega^2}{c^2} - k^2.$$

Действуя так же, как и в работе [5], найдем общее решение уравнений (8) и (7) без правой части в "нулевой ячейке" и, затем распространим его с помощью теоремы Флоке [6] на всю сверхрешетку. В "нулевой ячейке":

$$E_x = \begin{cases} A_1 e^{i\varepsilon_1 z} + A_2 e^{-i\varepsilon_1 z} & 0 < z < a \\ B_1 e^{i\varepsilon z} + B_2 e^{-i\varepsilon z} & -d < z < 0 \end{cases}$$

В произвольной ячейке номера N :

$$E_x^{(1,2)}(z + N(a+d)) = e^{ik_x^{(1,2)}(a+d)N} E_x(z) \quad (9)$$

Условие ограниченности решений (9) на $\pm\infty$ по N требует, чтобы константы $k_x^{(1,2)}$ были действительными, а из симметрии следует, что $k_x^{(1,2)} = \pm k_x$, $k_x > 0$. Таким образом, общее решение однородного уравнения для E_x во всей сверхрешетке есть:

$$E_x(z + N(a+d)) = e^{ik_x(a+d)N} E_x^+(z) + e^{-ik_x(a+d)N} E_x^-(z) \quad (10)$$

где $E_x^\pm(z)$ - решения в "нулевой" ячейке, отличающиеся значениями констант ($A_{1,2}^\pm$ и $B_{1,2}^\pm$). Конечно эти константы не все независимы, и число их будет сокращено до двух (как и положено для общего решения уравнения второго порядка) применением условий сшивания решений уравнений (7) и (8) на границах слоев.

Частное решение уравнения (7) в слоях типа *d* легко может быть найдено методом вариации произвольной постоянной. Оно имеет следующий вид:

$$E_x^0 = -\frac{4\pi\omega^2}{c^2} \Lambda_{||} \chi_{k\omega} \bar{E}_x \left[\frac{1}{\varepsilon^2} + \frac{d^2 \cos \frac{2\pi}{d} z}{(2\pi)^2 - \varepsilon^2 d^2} \right] \quad (11)$$

Если теперь к решению (10) в слоях типа *d* прибавить (11), то мы получим общее решение во всей сверхрешетке с учетом приведенного тока в слоях *d*. Вычисляя затем \bar{E}_x (см.(3)), можно убедиться, что это общее решение представляется в виде суммы двух линейно-независимых решений, пропорциональных $\exp[\pm ik_x(a+d)N]$ соответственно. Эти два решения должны сшиваться независимо на границах слоев. Сшиваться должны тангенциальные составляющие полей, т.е. E_x и H_y . При этом, согласно уравнению (5), непрерывность H_x обеспечивается автоматически.

Условия сшивания при $z=0$ дают возможность выразить $B_{1,2}^\pm$ через $A_{1,2}^\pm$, а на границе двух "ячеек" при $z=a$ дают две линейные однородные системы уравнений для $A_{1,2}^+$ и $A_{1,2}^-$ соответственно. Условия разрешимости обеих систем приводят к одному и тому же дисперсионному уравнению, связывающему ω , k и k_x . Для достаточно малых значений d и для частот, близких к экситонной $\hbar\omega_0 = \mathcal{E}_0$, можно считать параметр εd малым. Кроме того, как отмечено выше, мы считаем $\varepsilon \gg \varepsilon_1$ и, следовательно, $\varepsilon \gg \varepsilon_1$. В этих условиях дисперсионное уравнение имеет следующий вид:

$$\cos k_x(a+d) \approx \cos \varepsilon_1 a - \frac{1}{2} \varepsilon d \frac{\tilde{\varepsilon}_{||}}{\varepsilon \varepsilon_1} \sin \varepsilon_1 a, \quad (12)$$

где обозначено

$$\tilde{\varepsilon}_{||} = \varepsilon + 4\pi\Lambda_{||}\chi_{k\omega}. \quad (13)$$

$$\text{При этом } A_2^+ = \gamma A_1^+, \quad A_1^- = \gamma^* A_2^-, \quad (14)$$

$$B_{1,2}^+ = \frac{1}{2} \frac{\tilde{\varepsilon}_{||}}{\varepsilon} (1+\gamma) A_1^+, \quad B_{1,2}^- = \frac{1}{2} \frac{\tilde{\varepsilon}_{||}}{\varepsilon} (1+\gamma^*) A_2^-, \quad (15)$$

$$\gamma = -\frac{e^{ik_x(a+d)} - e^{i\varepsilon_1 a}}{e^{ik_x(a+d)} - e^{-i\varepsilon_1 a}}. \quad (16)$$

Таким образом, общее решение уравнений (4)-(6), удовлетворяющее граничным условиям на всех границах слоев сверхрешетки и конечное при $N \rightarrow \pm\infty$ есть:

$$E_x(z + N(a+d)) = A e^{ik_x(a+d)N} E_x(z) + B e^{-ik_x(a+d)N} E_x^*(z) \quad (17)$$

где

$$E_x(z) = \begin{cases} e^{i\alpha_1 z} + \gamma e^{-i\alpha_1 z} & 0 \leq z \leq a \\ \frac{\tilde{\epsilon}_{\parallel}}{\epsilon} (1 + \gamma) [\cos \alpha_1 z + \Delta(z)] & -d \leq z \leq 0 \end{cases} \quad (18)$$

$$\Delta(z) = -\frac{4\pi\omega^2}{c^2 \alpha_1^2} \Lambda_{\parallel} \chi_{i\omega} \frac{\epsilon}{\tilde{\epsilon}_{\parallel}} \left(1 + \frac{\alpha_1^2 d^2}{4\pi^2} \cos \frac{2\pi}{d} z \right), \quad (19)$$

а Λ и B - произвольные постоянные (фактически, это оставшиеся произвольными после процедуры шива-

ния A_1^+ и A_2^- соответственно).

Параметр k_z определяет разность фаз в соседних "ячейках" сверхрешетки. Он связан с ω и k дисперсионным уравнением (12). При заданных ω и k эта разность фаз фиксируется дисперсионным уравнением. Если же задавать k_z и k , то уравнение (12) определяет зависимость $\omega(k, k_z)$ в области существования ТЕ-поляритонов. Эта область ограничивается теми значениями ω и k , при которых правая часть дисперсионного уравнения по модулю не превышает единицы.

Решение дисперсионного уравнения вблизи экситонной частоты $\omega \approx \omega_0$ дает спектр ТЕ-поляритонов:

$$\omega \approx \omega_0 + \frac{\frac{\Delta_x \Lambda_{\parallel} c}{\tilde{\epsilon}_{\parallel} \omega_0} \frac{\alpha_1^2}{\alpha_1} \sin \alpha_1 a}{2 \cos k_z (a+d) - 2 \cos \alpha_1 a + \frac{\alpha_1}{\alpha_1} \alpha_1 d \sin \alpha_1 a}, \quad (20)$$

где $\Delta_x = 4\pi \frac{e^4 m |V_{cv}|^2}{\hbar^2 c \epsilon d \omega_0}$ и в (20) в α_1 и α_1 нужно вместо ω подставить ω_0 .

В слоях типа a в уравнениях (22) и (23) не будет членов с компонентами плотности тока, и вместо ϵ будет ϵ_1 . Из системы уравнений (21)-(23) легко получается уравнение второго порядка для E_y :

$$\frac{d^2 E_y}{dz^2} + \alpha_1^2 E_y = -i \frac{4\pi \alpha_1^2}{\epsilon \omega} j_y + \frac{4\pi k}{\epsilon \omega} \frac{dj_z}{dz}, \quad (24)$$

2. Поперечно-магнитные (ТМ) поляритоны.

В отличие от ТЕ-поляризации в ТМ-поляризации отличны от нуля следующие компоненты полей: $\vec{E}(0, E_y, E_x)$ и $\vec{H}(H_x, 0, 0)$. Система уравнений Максвелла в слоях типа d в данном случае имеет вид:

$$ikE_x - \frac{dE_y}{dz} = \frac{i\omega}{c} H_x \quad (21)$$

$$\frac{dH_x}{dz} = -\frac{i\omega}{c} \epsilon E_y + \frac{4\pi}{c} j_y \quad (22)$$

$$ikH_x = \frac{i\omega}{c} \epsilon E_x - \frac{4\pi}{c} j_z \quad (23)$$

а остальные компоненты полей выражаются через $\frac{dE_y}{dz}$ и j_z с помощью уравнений (21) и (23).

Процедура нахождения общего решения уравнения (24) и соответствующего уравнения (без правой части и с заменой α_1 на α_1) в слоях типа a , справедливой во всей сверхрешетке, такая же, как и в случае ТЕ-поляризации.

Частное решение уравнения (24) в данном случае имеет следующий вид:

$$E_y^0 = -\frac{4\pi \Lambda_{\parallel} \chi_{i\omega}}{\epsilon} \alpha_1^2 \bar{E}_y \left[\frac{1}{\alpha_1^2} + \frac{d^2 \cos \frac{2\pi}{d} z}{(2\pi)^2 - \alpha_1^2 d^2} \right] + i \frac{8\pi^2 \Lambda_{\perp} \chi_{i\omega}}{\epsilon d} k \bar{E}_z \frac{d^2 \sin^2 \frac{2\pi}{d} z}{(2\pi)^2 - \alpha_1^2 d^2} \quad (25)$$

Используя это частное решение и действуя так же, как и в случае ТЕ-волн, получаем общее решение для E_y , удовлетворяющее всем граничным условиям, в ви-

де, аналогичном (17), где вместо $E_x(z)$ нужно подставить $E_y(z)$:

$$E_y(z) = \begin{cases} e^{i\alpha_1 z} + \gamma_1 e^{-i\alpha_1 z} & 0 \leq z \leq a \\ \frac{\tilde{\epsilon}_{\parallel}}{\epsilon} (1 + \gamma_1) (\cos \alpha_1 z + \text{Re} \Delta_1) + i \frac{\tilde{\epsilon}_{\perp}}{\epsilon} \frac{\alpha_1}{\alpha_1} (1 - \gamma_1) (\sin \alpha_1 z + \text{Im} \Delta_1), & -d \leq z \leq 0 \end{cases} \quad (26)$$

$$\gamma_1 = - \frac{e^{ik_1(a+d)} \left(1 - i \frac{\tilde{\epsilon}_1}{\epsilon} \frac{\alpha}{\alpha_1} \alpha d \right) - e^{i\alpha_1 a}}{e^{ik_1(a+d)} \left(1 + i \frac{\tilde{\epsilon}_1}{\epsilon} \frac{\alpha}{\alpha_1} \alpha d \right) - e^{-i\alpha_1 a}}, \quad (27)$$

$$\Delta_1(z) = - \frac{4\pi\Lambda_{\parallel}\chi_{\tilde{\epsilon}\alpha}}{\tilde{\epsilon}_{\parallel}} \left(1 + \frac{\alpha^2 d^2}{4\pi^2} \cos \frac{2\pi}{d} z \right) - i \frac{2\Lambda_{\perp}\chi_{\tilde{\epsilon}\alpha} k^2 \alpha d}{\tilde{\epsilon}_1 \alpha^2 + 4\pi\Lambda_{\perp}\chi_{\tilde{\epsilon}\alpha} k^2} \sin \frac{2\pi}{d} z, \quad (28)$$

$$\tilde{\epsilon}_1 = \epsilon + 6\pi\Lambda_{\perp}\chi_{\tilde{\epsilon}\alpha}. \quad (29)$$

Дисперсионное уравнение, связывающее ω , k и k_z в данном случае довольно громоздко, и мы приведем

его в приближении $\alpha d \ll 1$ и $kd \ll 1$:

$$\cos k_1(a+d) \approx \cos \alpha_1 a - \frac{1}{2} \alpha d \left[\frac{\tilde{\epsilon}_{\parallel} \alpha_1}{\epsilon_1 \alpha} + \frac{\epsilon_1 \alpha}{\epsilon \alpha_1} \left(1 + \frac{4\pi\Lambda_{\perp}\chi_{\tilde{\epsilon}\alpha} k^2}{\tilde{\epsilon}_1 \alpha^2} \right) \right] \sin \alpha_1 a. \quad (30)$$

Из этого дисперсионного уравнения получаются две ветви ТМ-полукритонов. Одна - вблизи экситонной частоты ω_0 в пределе $kd \ll 1$ и $\epsilon_1 \ll \epsilon$ не отличается от (20). Вторая ветвь - вблизи частоты ω_1

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 + 12\pi\Lambda_{\perp} \left(\frac{e^2}{\epsilon \hbar d} \right)^2 \frac{m|V_{cv}|^2}{\hbar \omega_0}, \quad (31)$$

существующая только в случае, когда $\Lambda_{\perp} \neq 0$, имеет вид

$$\omega \approx \omega_1 + \frac{\frac{\epsilon_1 d}{\epsilon \alpha_1} \frac{\omega_0}{\omega_1} \Lambda_{\perp} \frac{\Delta_{\kappa}}{\hbar} k^2 \sin \alpha_1 a}{2 \cos k_1(a+d) - 2 \cos \alpha_1 a + \alpha d \left(\frac{\tilde{\epsilon}_{\parallel} \alpha_1}{\epsilon_1 \alpha} + \frac{\epsilon_1 \alpha}{\epsilon \alpha_1} \right) \sin \alpha_1 a}, \quad (32)$$

где $\Delta_{\kappa} = 4\pi \left(\frac{e^2}{\epsilon \hbar \omega_0} \right)^2 m|V_{cv}|^2$ и в α , α_1 и $\tilde{\epsilon}_{\parallel}$ в этом выражении нужно замесить ω на ω_1 .

- [1] Л.В. Келдыш. Письма в ЖЭТФ. 1979, т.30, в.4, с.244-248.
 [2] Л.В. Келдыш. Письма в ЖЭТФ. 1979, т.29, в.11, с.716-719.
 [3] Р.Р. Гусейнов. ФТТ, 1984, т.26, в.6, с.1908-1910.
 [4] R.R. Guseinov. Phys.Stat.Sol.(b), 1984, v.125,

- р.237-243.
 [5] Э.Р. Гусейнов. Fizika (Баку), 1996, т.2, №2, с.6-8.
 [6] Э.Камке. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям, 1961, Москва, Физматгиз.

E.R. Hüseynov, R.R. Hüseynov

YARIMKEÇİRİCİ İFRATQƏFƏSDƏ POLYARİTONLAR

Yarımkəçirici ifratqəfəsdə, tezlikləri eksiton tezliklərinə yaxın olan elektromaqnit dalğalarının-polyaritonların yayılması mümkünlüyünə baxılmışdır. Mühitin elektromaqnit reaksiyasını nəzərə almaqla Maksvell tenliklərinin həlli tapılmışdır. TE və TM-polyaritonların spektri alınmışdır.

E.R. Guseinov, R.R. Guseinov

POLARITONS IN A SEMICONDUCTOR SUPERLATTICE

The possibility of spreading of the electromagnetic waves-polaritons with the frequencies near to the excitonic ones in a semiconductor superlattice is considered. The solutions of the Maxwell equations taking into account the electromagnetic response of the medium are found and the spectrum of TE and TM-polaritons are calculated.

Редактор: Ю.М. Семенов